

# 2SK777



2056

NチャンネルMOS形  
シリコン電界効果トランジスタ

## 超高速スイッチング用

©2561

特長 ・低オン抵抗, 超高速スイッチング。

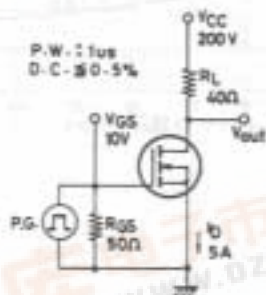
### 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/Ta=25°C

			unit
ドレイン-ソース電圧	V <sub>DS</sub>	450	V
ゲート-ソース電圧	V <sub>GS</sub>	±20	V
ドレイン電流(D.C.)	I <sub>D</sub>	10	A
ドレイン電流(Pulse)	I <sub>D peak</sub>	20	A
許容損失	P <sub>D</sub>	120	W
接合部温度	T <sub>j</sub>	150	°C
保存周囲温度	T <sub>stg</sub>	-55~+150	°C

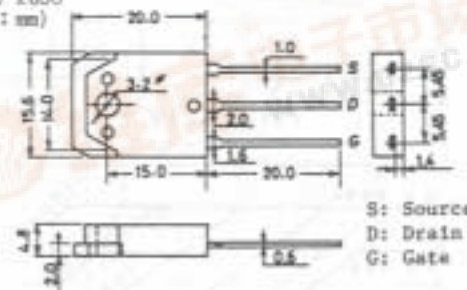
### 電気的特性 Electrical Characteristics/Ta=25°C

			min	typ	max	unit
ドレイン-ソース降伏電圧	V <sub>DS</sub>	I <sub>D</sub> =1mA, V <sub>GS</sub> =0	450			V
ドレイン-ソースしゅ断電流	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> =450V, V <sub>GS</sub> =0			1.0	mA
ゲート-ソースもれ電流	I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> =±20V, V <sub>DS</sub> =0			±100	nA
ゲート-ソースしゅ断電圧	V <sub>GS(off)</sub>	V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1mA	1.5		4.0	V
順伝達ファクタ	Y <sub>fs</sub>	V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =5A	3	4.5		S
飽和抵抗	R <sub>DS(on)</sub>	I <sub>D</sub> =5A, V <sub>GS</sub> =10V		0.47	0.65	Ω
入力容量	C <sub>iss</sub>	V <sub>DS</sub> =20V, f=1MHz		1600		pF
出力容量	C <sub>oss</sub>	V <sub>DS</sub> =20V, f=1MHz		250		pF
帰還容量	C <sub>rss</sub>	V <sub>DS</sub> =20V, f=1MHz		80		pF
ターンオン遅延時間	t <sub>d(on)</sub>	I <sub>D</sub> =5A, V <sub>GS</sub> =10V V <sub>CC</sub> =200V, R <sub>GS</sub> =50Ω		30	60	ns
立ち上がり時間	t <sub>r</sub>		90	180	ns	
ターンオフ遅延時間	t <sub>d(off)</sub>		250	500	ns	
下降時間	t <sub>f</sub>		80	160	ns	

### スイッチングタイム測定回路



外形図 2056  
(unit: mm)



S: Source  
D: Drain  
G: Gate

SANYO: TO3PB

注: ゲート-ソース間には保護回路ダイオードは入っていないため 取扱いに十分注意すること。

